（前のページより続き）

○予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十八年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道農政事務所長に委任した件の一部を改正する件（同二一九五）

○予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件の一部を改正する件（同二一九六）

〔官庁報告〕

官庁事項

人事院規則二―四（人事院の職員に対する権限の委任）第二項の規定に基づき、昭和三十八年人事院公示第五号の一部を改正に関し、決定した件

（人事院公示一七）

人事院規則二―四（人事院の職員に対する権限の委任）第二項の規定に基づき、平成二十一年人事院公示第八号の一部を改正に関し、決定した件

（同一八）

本号で公布された法令のあらまし

◇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律（法律第八六号）（国会）

1　議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三五条の規定にかかわらず、令和四年七月三一日までの間は、歳費月額に一〇〇分の八〇を乗じて得た額とすることとした。（附則第一九項関係）

2　この法律は、令和四年一月一日から施行することとした。

◇特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律（法律第八七号）（経済産業省）

一　特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の一部改正関係

1　目的

この法律は、情報通信技術の分野における技術革新の進展及び我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に伴い、国民生活及び経済活動の基盤となる特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等がサイバーセキュリティ（サイバーセキュリティ基本法第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。）を確保しつつ適切に行われるとともに特定高度情報通信技術活用システムに不可欠な特定半導体が我が国の技術の向上により国内で安定的に生産されることが我が国における産業基盤を整備する上で重要であることに鑑み、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針の策定、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画及び特定半導体生産施設整備等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずることにより、特定高度情報通信技術活用システムの普及を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展並びに我が国の安全保障に寄与することを目的とすることとした。（第一条関係）

2　定義

㈠　この法律において「特定半導体」とは、特定高度情報通信技術活用システムに不可欠な大量の情報を高速度で処理することを可能とする半導体であって、国際的に生産能力が限られていることその他の事由により国内で安定的に生産することが特に必要なものとすることとした。（第二条第四項関係）

㈡　この法律において「特定半導体生産施設整備等」とは、次に掲げるものとすることとした。

(1)　特定半導体の生産施設の整備及び当該生産施設における生産（第二条第五項第一号関係）

(2)　特定半導体の生産に不可欠な半導体材料又は半導体生産装置であって国際的に生産能力が限られていることその他の事由により国内で安定的に生産することが特に必要なもの（以下「特定半導体材料等」という。）の生産施設の整備及び当該生産施設における生産（第二条第五項第二号関係）

3　基本理念

特定半導体生産施設整備等は、特定半導体が特定高度情報通信技術活用システムに不可欠なものであり、かつ、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることに鑑み、国際的に特定半導体の生産能力が限られている状況においてもその需給の変動に対応できるよう我が国の技術の向上により特定半導体の国内における安定的な生産を確保すること、及び我が国における特定半導体の生産に関係する産業の発展に資することを旨とし、国及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ行うものとすることとした。（第三条第二項関係）

4　特定半導体生産施設整備等計画の認定等

㈠　主務大臣は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針（以下「指針」という。）に、特定半導体生産施設整備等に関する事項を定めるものとすることとした。（第六条関係）

㈡　特定半導体生産施設整備等を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定半導体生産施設整備等に関する計画（以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。）を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができるものとすることとした。（第一一条第一項関係）

㈢　主務大臣は、特定半導体生産施設整備等計画が次のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとすることとした。

(1)　当該特定半導体生産施設整備等計画の内容が指針に照らし適切なものであること。（第一一条第三項第一号関係）

(2)　当該特定半導体生産施設整備等計画に基づく特定半導体又は特定半導体材料等（以下「特定半導体等」という。）の生産が一定期間以上継続的に行われると見込まれるものであること。（第一一条第三項第二号関係）

(3)　当該特定半導体生産施設整備等計画に係る特定半導体生産施設整備等が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。（第一一条第三項第三号関係）

(4)　特定半導体等の需給がひっ迫した場合における増産、特定半導体等の生産能力を強化するための投資及び研究開発その他特定半導体の国内における安定的な生産に資する取組が行われると見込まれるものであること。（第一一条第三項第四号関係）

(5)　特定半導体等に係る技術上の情報を適切に管理するための体制が整備されていること。（第一一条第三項第五号関係）

㈣　主務大臣は、㈡の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができるものとすることとした。（第一一条第四項関係）

㈤　主務大臣は、㈡の認定をしたときは、当該認定に係る特定半導体生産施設整備等計画の概要を公表するとともに、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という。）に当該認定をした旨を通知するものとすることとした。（第一一条第五項関係）

㈥　㈡の認定に係る特定半導体生産施設整備等計画（以下「認定特定半導体生産施設整備等計画」という。）の変更、認定の取消し、報告の徴収等について規定することとした。（第一二条及び第三二条関係）